








	<p>IPI100N08N3GHKSA1</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IPI100N08N3GHKSA1</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 80V 70A TO262-3</p> <p>Datenblätter:  IPI100N08N3GHKSA1.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPI100N08N3GHKSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 70A TO262-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 46µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO262-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	10 mOhm @ 46A, 10V
Verlustleistung (max)	100W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2410pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	35nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	70A (Tc)

IPI100N08N3GHKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPI100N08N3GHKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPI100N08N3GHKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPI100N08N3GHKSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPI100N10S305AKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 100A TO262-3</p>	 <p>IPI100N06S3-03 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 100A I2PAK</p>	 <p>IPI100N08S207AKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 75V 100A TO262-3</p>	 <p>IPI100N06S3L04XK Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 100A TO-262</p>
 <p>IPI100N04S4H2AKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 100A TO262-3-1</p>	 <p>IPI110N20N3GAKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 200V 88A TO262-3</p>	 <p>IPI100P03P3L-04 Infineon Technologies MOSFET P-CH 30V 100A TO262-3</p>	 <p>IPI100N06S3L-03 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 100A TO-262</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPI100N08N3GHKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPI100N08N3GHKSA1 Datenblatt	IPI100N08N3GHKSA1-Datenblätter	IPI100N08N3GHKSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPI100N08N3GHKSA1
IPI100N08N3GHKSA1 Electronic	IPI100N08N3GHKSA1-Komponenten	IPI100N08N3GHKSA1-Verteiler	IPI100N08N3GHKSA1-Bild	IPI100N08N3GHKSA1-Teil
IPI100N08N3GHKSA1 Preis	IPI100N08N3GHKSA1 Hersteller	IPI100N08N3GHKSA1 Bild	IPI100N08N3GHKSA1 Aktie	IPI100N08N3GHKSA1 Inventar
IPI100N08N3GHKSA1 Neu	IPI100N08N3GHKSA1 Original	IPI100N08N3GHKSA1 garantiert	IPI100N08N3GHKSA1 RFQ	IPI100N08N3GHKSA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited